

B - 1 次の記述は、電界効果トランジスタ (FET) について述べたものである。□ 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

- (1) トランジスタを大別するとバイポーラトランジスタとユニポーラトランジスタの二つがあり、このうち FET は ア トランジスタに属する。また、FET の構造が、金属 - 酸化膜 (絶縁物) - 半導体により構成されているものを イ FET という。MOS
- (2) シリコン半導体に代わり、化合物半導体の ウ を用いた FET は、電子移動度が エ、オ 特性が優れているため、マイクロ波の高出力増幅器等に広く用いられている。カリウム化合物 大きく 高周波

- 1 大きく 2 ガリウムヒ素 (GaAs) 3 低周波 4 接合形 5 ユニポーラ
6 小さく 7 ニッケルカルコゲニウム (NiCd) 8 高周波 9 MOS 10 バイポーラ

